

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER : 56006492
PUBLICATION DATE : 23-01-81

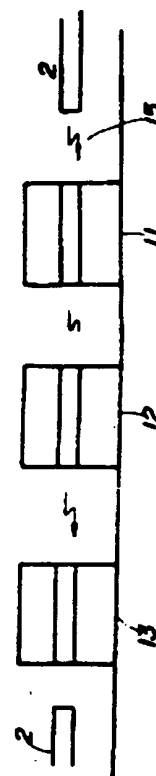
APPLICATION DATE : 26-06-79
APPLICATION NUMBER : 54081204

APPLICANT : SHARP CORP;

INVENTOR : INOUE TADAAKI;

INT.CL. : H01S 3/18 H01L 31/00 H01L 33/00

TITLE : LIGHT AMPLIFIER



ABSTRACT : PURPOSE: To obtain an output signal having high S/N ratio from a light amplifier by coupling semiconductor lasers having different oscillation outputs on a light irradiating line and sequentially coupling between the respective semiconductor lasers to input signal.

CONSTITUTION: A semiconductor laser (LD) 11 of the first stage is in oscillated state, and is moved slightly in the oscillated state toward an increase in the output by the coupling effect of an input light signal inputted from a fiber 2. An LD 12 of the second stage is turned on due to the increase in the oscillation due to the coupling effect of the LD 11 of the first stage to start oscillation. Although an LD 13 of the third stage is set in oscillated state, when the LD 12 of the second stage starts oscillating, it transfers its oscillating state so as to transmit the light signal due to only the delay of the coupling time.

COPYRIGHT: (C)1981,JPO&Japio

⑨ 日本国特許庁 (JP)

⑩ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報 (A)

昭56—6492

⑪ Int. Cl.³

識別記号

庁内整理番号

⑬ 公開 昭和56年(1981)1月23日

H 01 S 3/18

7377—5 F

H 01 L 31/00

6824—5 F

発明の数 1

33/00

7739—5 F

審査請求 未請求

(全 4 頁)

⑭ 光増幅器

大阪市阿倍野区長池町22番22号

シャープ株式会社内

⑮ 特 願 昭54—81204

⑯ 発 明 者 井上忠昭

⑰ 出 願 昭54(1979)6月26日

大阪市阿倍野区長池町22番22号

⑱ 発 明 者 富田孝司

シャープ株式会社内

大阪市阿倍野区長池町22番22号

⑲ 出 願 人 シャープ株式会社

シャープ株式会社内

大阪市阿倍野区長池町22番22号

⑳ 発 明 者 幸木俊公

㉑ 代 理 人 弁理士 福士愛彦

明 細 書

1. 発明の名称

光増幅器

2. 特許請求の範囲

1. 複数の半導体レーザをレーザ光放射面上に配設し、各半導体レーザ間をレンズで光結合せしめるとにより伝送された光信号を増幅することを特徴とする光増幅器。

2. 前記半導体レーザは同一基板上に形成された半導体レーザアレイで構成された特許請求の範囲第1項記載の光増幅器。

3. 発明の詳細な説明

本発明は半導体レーザを用いた光通信技術に於ける光増幅器に関するものである。

光ファイバの高性能化、低コスト化に伴い、光通信技術が実用化される段階にまで至っているが、長距離光通信の場合、その伝送距離はファイバの材料の特性から決定される吸収損失並びにファイバの開口角等の形状的、材料の特性から決定

される周波数損失によりその範囲が限定されてしまう。特に10 km以上の光情報伝送の場合は伝送速度が速く、かつファイバ内入力を大きくできる半導体レーザの利用が有望となるが周波数100 MHz以上で100 km以上の大都市間等の情報伝送の場合にはファイバによる吸収損失等を考慮すると中継器が必要となる。特に海洋ケーブル等として用いた場合には中継器は軽量、小型かつ高信頼性のものが必要である。

従来考えられている光中継器の構造としては、図1図に示す如くA点よりファイバ(1)を通して送られて来た光を一度アバランシエホトダイオード等の高感度光素子(2)で電気信号に変換するとともに該電気信号を増幅器(3)で増幅し、再び半導体レーザ(4)の入力信号とする方式が採用されてきた。しかしながらこの方式ではアバランシエホトダイオードの高価な点や、高感度増幅器の必要性及び中継器の複雑化、各エレメントの増加による信頼性の低下、中継器自身の巨大化等により中継器としては好ましくない点が多い。

また、光増幅作用を有する半導体レーザの光カ
ップリング効果（自己結合効果）を用いて半導体
レーザ自身を光中継器として利用することが提案
されているが、第2図に示す如く、地点より送ら
れてきた光情報は、中継器のある地点では光量
はファイバ内での吸収できわめて小さくなり、光
カッピング効果は起つていても $\frac{P}{P_0}$ 比はきわめ
て低く、地点に充分検知し得る信号を送ることが
不可能である。

尚、図中実線は入力のない場合、虚線は入力
が有る場合の特性図である。

本発明は以上の点に鑑み、各発振出力の異なる
半導体レーザを光放射線上に結合させ、入力信号
を各半導体レーザ間で順次カッピングを起こさ
せることにより $\frac{P}{P_0}$ 比の高い出力信号を得ること
のできる半導体レーザアレイの光増幅器を提供す
ることを目的とするものである。

尚、以下の実施例では本発明の原理を明らかに
する為、3つの半導体レーザアレイを用いた例を
示すが高い出力信号を得る為にはレーザダイオー

(3)

各個別化した半導体レーザアレイを使用する。第
3図に示す如く各レーザの設定電流が外部抵抗 R_L
(20)で制御可能であることは同素子の使用上の
利便性を増す。

以上により基板のアレイは高さ方向にそろえる
ことが極めて容易でカッピング効率を高め製造
コストを低減することができる。

半導体レーザの材料としては本発明では $(\text{InAs})_x$
上に $(\text{GaAlAs})_{1-x}$ GaAs $(\text{GaAlAs})_x$ を換相成長させた
ダブルヘテロ構造の基板を使用した材料は
 $\text{In}_x\text{Ga}_{1-x}\text{AsP}$ 等のダブルヘテロを形成する材料や、
他のIII-V族半導体に於いても適用可能であり、
特にアパランシエダイオードの作り難い材料に
対しては極めて有望である。

次にレーザアレイのアラインメントについて説
明する。第3図に示したレーザアレイを同一線上
に並べると入力信号(24)が入力される以前に相互
カッピングを起こしてしまい実質上光増幅は行
なわれない。即ち、光の進行方向性に個性をもた
せるために各素子間に光アイソレータが必要であ

(5)

特開昭56-6492(2)

ドを更に加えてもよく個数に關しては3つに限定
するところではない。第3図は本発明の原理を説
明するための説明図である。図に示す如く第1段
目の半導体レーザ(11)（以下LDと略す）は第4
図(A)に示す発振状態にありファイバ(2)より来る入
力光信号によりカッピング効果によりわずかに
発振状態が点(100)より出力増加の方向へ点(101)
まで移行する。第2段目のLD(12)は第4図(B)に
示す如く発振開始電流(102)まで電流印加さ
れているが第1段目のLD(11)の、カッピング
効果による発振増加によりターンオンし点(103)
で発振を開始する。第3段目のLD(13)は第4図
(C)に示す如く点(104)で示すある発振状態に置か
れているが第2段目のLD(12)の発振開始とともに
点(105)の発振状態に移行し、地点にカッピング
時間の遅れのみで光信号を伝送することが可
能である。

半導体レーザアレイは特性的に同一のものが望
ましく、この点を考慮して本発明の他の特徴でも
ある同一基板上にかつエンタングプロセスにより

(4)

るが、本実施例では各LDのアラインメントとレ
ンズ結合に技術的手段を駆使することによって性
性を付与した。第6図は半導体レーザアレイを平
面方向よりみた図である。ファイバ(24)より伝送
されてきた光信号(25)は集光レンズ(26)によりLD
(11)に照射され、カッピングをおこす。LD(11)
の出力がファイバ(24)に入射されない様にファイ
バ(24)と集光レンズ(26)を配置する。LD(11)のス
トラップ(27)の出力端には第7図(A)に示すX-Y
面にカーバを有するレンズ(28)が設置されており、
LD(12)のストライプ(29)に入射される。LD(12)
よりの入力端面(30)より出るレーザ光(31)はLD
(11)に入射されることによる散乱を防ぐ為にレ
ンズ表面の一部にAと蒸着部分(32)を設けてある。
また同様のレンズをLD(13)にも付設する。LD
(11)の出力端面(33)より出た光は半円柱レンズの
カーバ角度 θ (34)とレンズ材質の屈折率 n で決定
される角度を θ とすると

$$\theta = \sin^{-1} (n \sin \theta)$$

の方向に放射される。 θ が大きい程、逆方向のカ

(6)

ツブリングが小さく、 $\frac{1}{\mu}$ 比の高い光増幅器が得られることになるが反面 LD 間の順方向の信号量の結合度が低下する。本発明では θ を 2° より 30° の間に設定した時に最大の効率が得られた。このことは活性層材料の屈折率が $n=3.5 \sim 4$ と大きい為 θ の角度が多小大きくとも LD 内に入射された光はストライプ方向に屈折され θ の許容値を大きくとることができることを意味する。また θ の角度が $2^\circ \sim 30^\circ$ であると、LD (12) より LD (11) への逆カップリングが防止され LD (11) 側になんら影響されることはない。各ダイオード間の間隔はテーパ角 θ で決定されレーザストライプ長の 0.5 倍の長さにとることができるが θ が大きくなると逆方向のカップリングが少なくなる反面順方向のカップリング量が低下しモノリシック化が行われなくなりストライプ長の 0.1~0.5 倍程度が最適である。LD (12) より放射した光は次の LD (13) のストライプに入射される傾角度 θ と距離 d で一般的に決定される位置に設ける必要がある。

(7)

平面部 (40) はレーザ端面と密着させる必要があるが、フレイクシリタイルの良質な材料の方が望ましい。またレンズ表面のレーザ光反射部に於いては Au を蒸着した。第 7 図 (a) はレーザ端面にレンズを密着した図である。半円柱レンズ長は 100~500 μm とし、製造工程上容易な長さとしたが実質的には上記の長さで限定されるものではない。レーザ間隔が 50 μm の場合に於いてはレンズは 100 μm 程度の円柱ファイバの一端より研磨し特に中央部で充分研磨塑性変形させることによりテーパ角をつけたが製造法は上記実施例に限ることなく利用すべきテーパ状円柱レンズを用いることができる。

以上の様に作られた光増幅器は入力信号を電気信号に変換することなく光による結合で増幅する方式により 20 dB 以上ディレイタイム 0.1 ns 以下の光増幅器ができた。またレーザアレイ温度の定常化をペルチェ素子で計ることは素子の安定性を増すことになる。

※ 図面の簡単な説明

(8)

特開 56-6492 (3)

以下、第 5 図に示す半導体レーザダイオードアレイの構造及び製造方法について説明する。(100) n 型 GaAs 基板 (30) 上に溶液法により液相成長された第 1 層 n-Ga_{0.7}Al_{0.3}As (31)、第 2 層 p-GaAs (32)、第 3 層 p-Ga_{0.7}Al_{0.3}As (33)、第 4 層 p-GaAs (34)、を順次形成する。電流閉じ込め用に Al₂O₃ (35) を CVD 蒸着し p 側電極 (36) を付けた 5 μm のストライプ幅をもつ電極ストライプ構造である。n 側電極 (37) としては Au-Ge-Ni 合金を蒸着した。各半導体レーザの電極ストライプ幅は同一にする必要はなく所望の光増幅率を考慮し各半導体レーザごとに変換することは可能であり微分量子効率の優れた半導体レーザダイオードを使うことが望ましい。各レーザのストライプ長さは 300 μm 、間隔は 50 μm とした。各レーザの個別化はストライプ形成後ホトエッチング法により硫酸系エッチング液を用いて行ない GaAs 基板の一部に至るホトエッチングを行なった。レンズ形状は円柱状の均一屈折率をもつ石英及び有機材料を第 7 図 (a) に示す如く加工した。レン

(9)

第 1 図は従来の光通信方式における中継器の模式図である。第 2 図は原料を入力光と、半導体レーザのカップリングによるレーザ出力の変化を示すグラフである。第 3 図は本発明の 1 実施例を示す半導体レーザの原理説明図である。第 4 図は第 3 図に示す半導体レーザそれぞれのカップリングによる出力変化を示す説明図である。

第 5 図は本発明の 1 実施例を示すモノリシック化された半導体レーザアレイの構成図である。

第 6 図は第 5 図に示すモノリシック化された半導体レーザアレイとレンズの配置を示す平面図である。

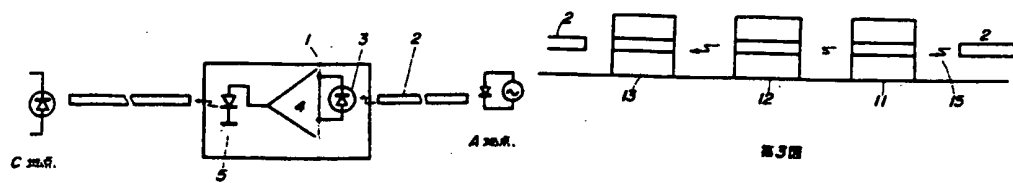
第 7 図は本発明の 1 実施例を示すカップリング用レンズの形状を模写したときの斜視図である。

11, 12, 13 半導体レーザ、14 ファイバ、15 集光レンズ。

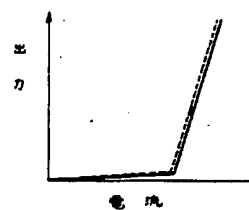
代理人 弁理士 福 士 愛 彦

00

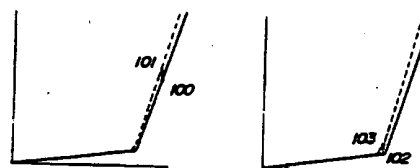
特開56-6492(4)



第3図



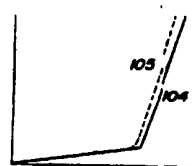
第2図



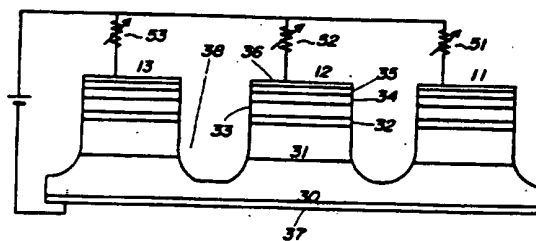
(A)

(B)

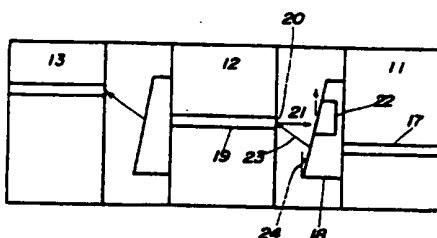
第4図



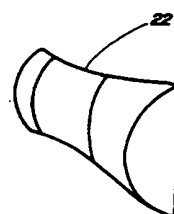
(C)



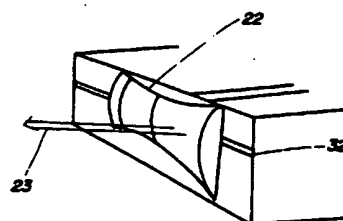
第5図



第6図



(A)



(B)

第7図